

Title (en)

METHOD FOR PRODUCING SEMI-CONDUCTOR DEVICES.

Title (de)

VERFAHREN ZUM HERSTELLEN VON HALBLEITERBAUELEMENTEN.

Title (fr)

PROCEDE POUR LA FABRICATION DE DISPOSITIFS SEMI-CONDUCTEURS.

Publication

EP 0020395 A1 19810107 (DE)

Application

EP 79901089 A 19800325

Priority

DE 2837750 A 19780830

Abstract (en)

[origin: WO8000510A1] To provide onto a substrate of a semi-conductor device a poly or monocrystalline layer of semiconductor material (27) (a polycrystalline layer in the case of solar cells for example), the material is deposited in an amorphous form onto the substrate, vaporised for example, and by means of a thermal treatment by optical radiation (4) applied onto the material, transformed into a poly or monocrystalline layer.

Abstract (fr)

Pour realiser sur un substrat d'un dispositif a semi-conducteur une couche de materiau semi-conducteur (27) poly-ou monocristalline (une couche polycristalline dans le cas par exemple d'une cellule solaire), le materiau est depose sous forme amorphe sur le substrat par exemple vaporise, puis au moyen d'un traitement thermique par un rayonnement optique (4) applique sur le materiau, transforme en une couche poly- ou monocristalline.

IPC 1-7

H01L 21/268; **H01L 31/18**; **C30B 1/02**

IPC 8 full level

C23C 14/16 (2006.01); **C23C 14/58** (2006.01); **C30B 1/02** (2006.01); **H01L 21/268** (2006.01); **H01L 31/18** (2006.01)

CPC (source: EP)

C23C 14/16 (2013.01); **C23C 14/58** (2013.01); **C23C 14/5813** (2013.01); **C23C 14/584** (2013.01); **C30B 1/023** (2013.01); **H01L 21/268** (2013.01); **H01L 31/186** (2013.01); **Y02E 10/50** (2013.01); **Y02P 70/50** (2015.11)

Designated contracting state (EPC)

FR

DOCDB simple family (publication)

WO 8000510 A1 19800320; DE 2837750 A1 19800313; EP 0020395 A1 19810107

DOCDB simple family (application)

DE 7900097 W 19790829; DE 2837750 A 19780830; EP 79901089 A 19800325